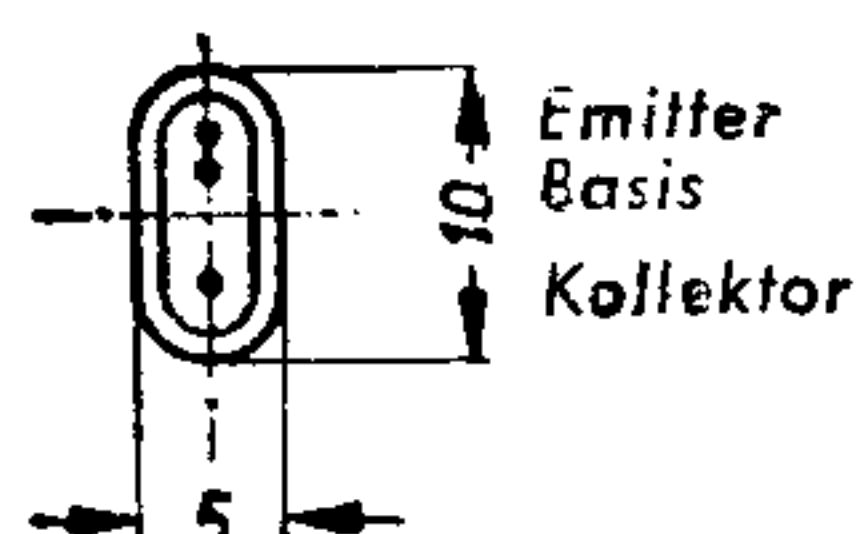
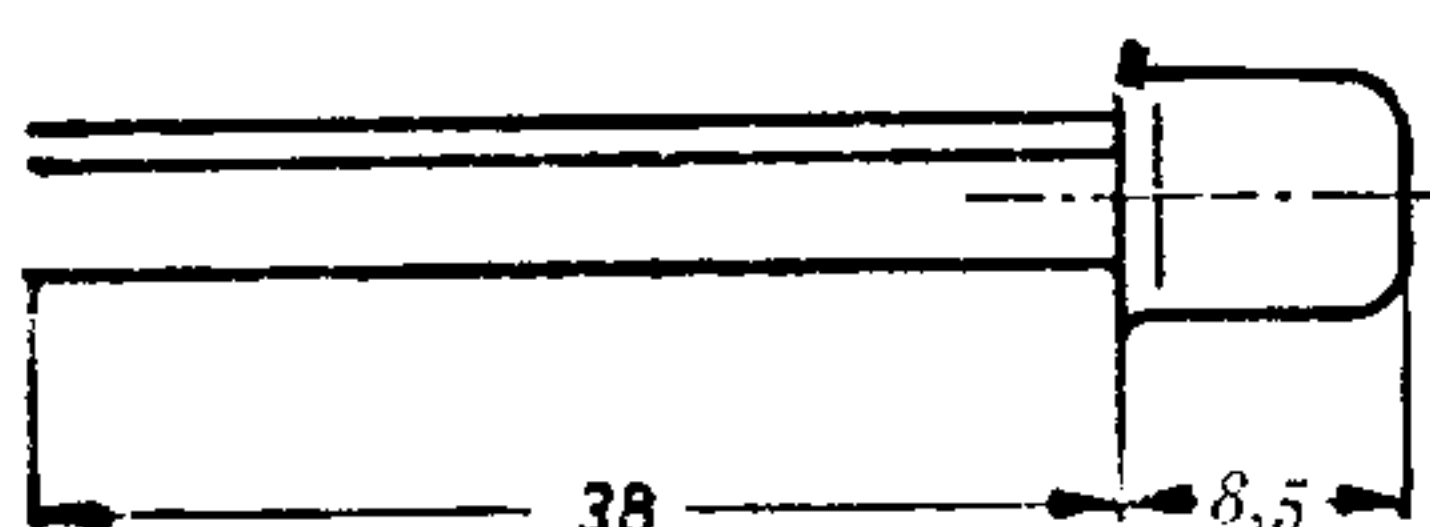


FLÄCHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 815
p-n-p-Flächentransistor
In Vorbereitung



Verwendung:

Der Transistor OC 815 ist ein p-n-p-Flächentransistor für Vorstufen in Niederfrequenzverstärkern, für Steuer- und Regelzwecke und als Schwingungserzeuger in Oszillatoren.

Kennwerte:

Emitterschaltung gemessen bei

$\vartheta_a = 25^\circ \text{ C}$; $-U_{CE} = 6 \text{ V}$ $-J_C = 2 \text{ mA}$; $f = 1 \text{ kHz}$

Kurzschluß-Eingangswiderstand $h'_{11} = 0,2 \dots 1,5 \text{ k}\Omega$

Leerlauf-Spannungsrückwirkung $h'_{12} = 4 \dots 25 \cdot 10^{-4}$

Kurzschluß-Stromverstärkung $h'_{21} = 10 \dots 20$

Leerlauf-Ausgangsleitwert $h'_{22} = 10 \dots 100 \mu\text{S}$

Leistungsverstärkung $G' = 30 \dots 42 \text{ dB}$

(bei $-U_{CE} = 6 \text{ V}$; $-J_C = 1 \text{ mA}$; $R_L = 50 \text{ k}\Omega$)

Rauschfaktor $F < 25 \text{ dB}$

(bei $-U_{CE} = 1 \text{ V}$; $-J_C = 1 \text{ mA}$; $R_g = 500 \Omega$; $f = 1 \text{ kHz}$)

Grenzfrequenz $f_\alpha > 200 \text{ kHz}$

(gemessen in Basisschaltung bei $-U_{CB} = 6 \text{ V}$; $-J_C = 2 \text{ mA}$)

Änderungen vorbehalten

FLÄCHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 815 p-n-p-Flächentransistor In Vorbereitung

Maximalwerte:

Kollektorreststrom

$$\text{bei } -U_{CB} = 6 \text{ V } J_E = 0 : -J_{co} \leq 20 \text{ } \mu\text{A}$$

$$\text{bei } -U_{CE} = 6 \text{ V } J_B = 0 : -J'_{co} \leq 400 \text{ } \mu\text{A}$$

$$\text{Kollektorrestspannung } -U_R \leq 0,3 \text{ V}$$

(bei $-J_C = 10 \text{ mA}$)

$$\text{Kollektorspannung } -U_{CEmax} = 10 \text{ V}$$

$$\text{Kollektorspitzenspannung } -U_{CEsp} = 15 \text{ V}$$

$$\text{Kollektorstrom } -J_{Cmax} = 20 \text{ mA}$$

$$\text{Kollektorspitzenstrom } -J_{Csp} = 50 \text{ mA}$$

$$\text{Verlustleistung } N_{Vmax} = 50 \text{ mW}^1)$$

$$\text{Sperrschichttemperatur } \vartheta_{jmax} = 65 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\text{Wärmewiderstand } \kappa = 0,4 \text{ } ^\circ\text{C/mW}$$

$$\text{Temperaturbereich } \vartheta_a = -40 \dots +65 \text{ } ^\circ\text{C}$$

¹⁾ Gesamte im Transistor auftretende Verlustleistung. (Emitter- und Kollektorverlustleistung.) Sie ist abhängig von der Umgebungstemperatur. s. Bl. OC 816 Seite 5

Änderungen vorbehalten

FLÄCHENTRANSISTOREN

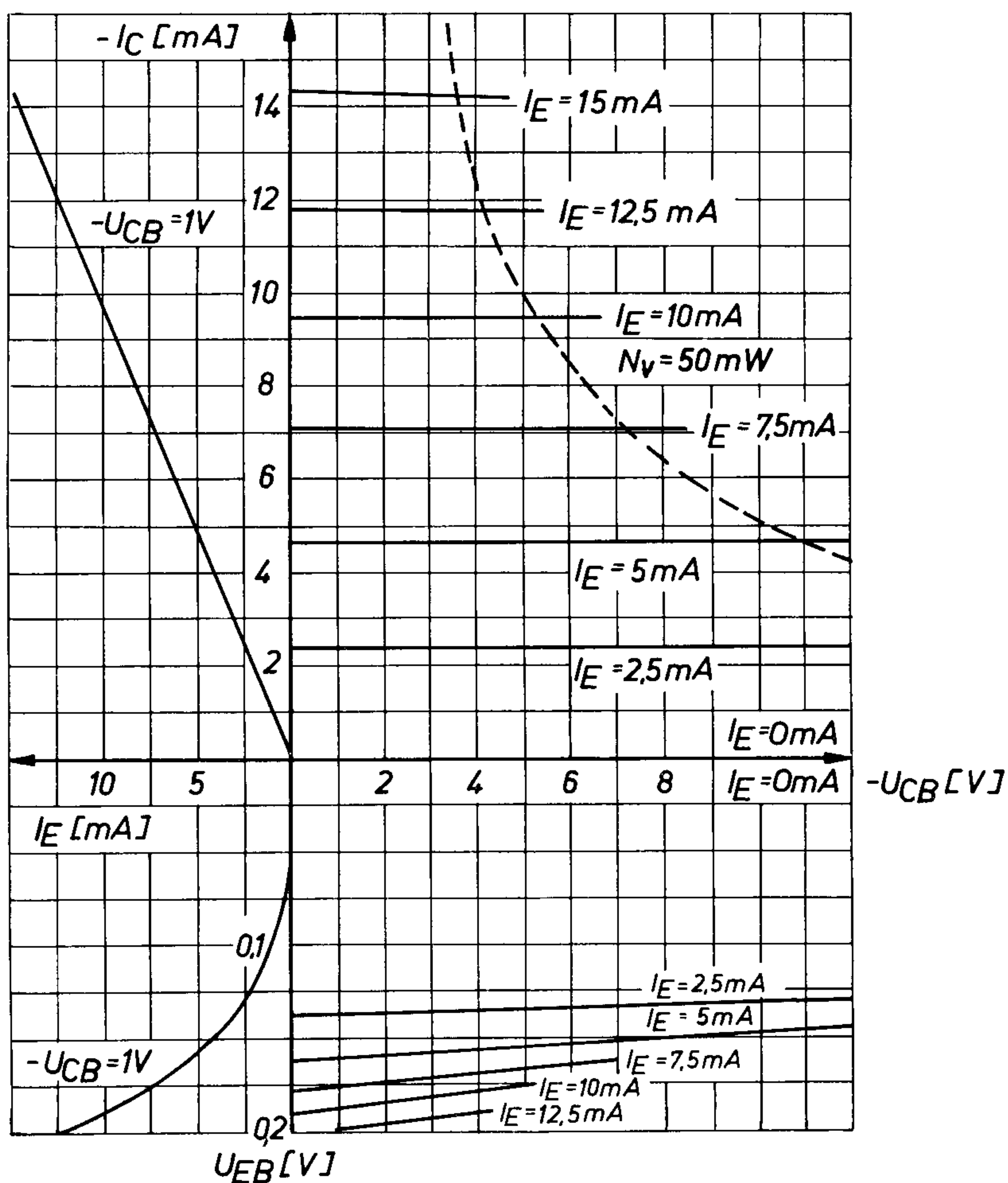
Ausgabe: November 1957

OC 815

p-n-p-Flächentransistor

In Vorbereitung

Kennlinienfeld in Basisschaltung

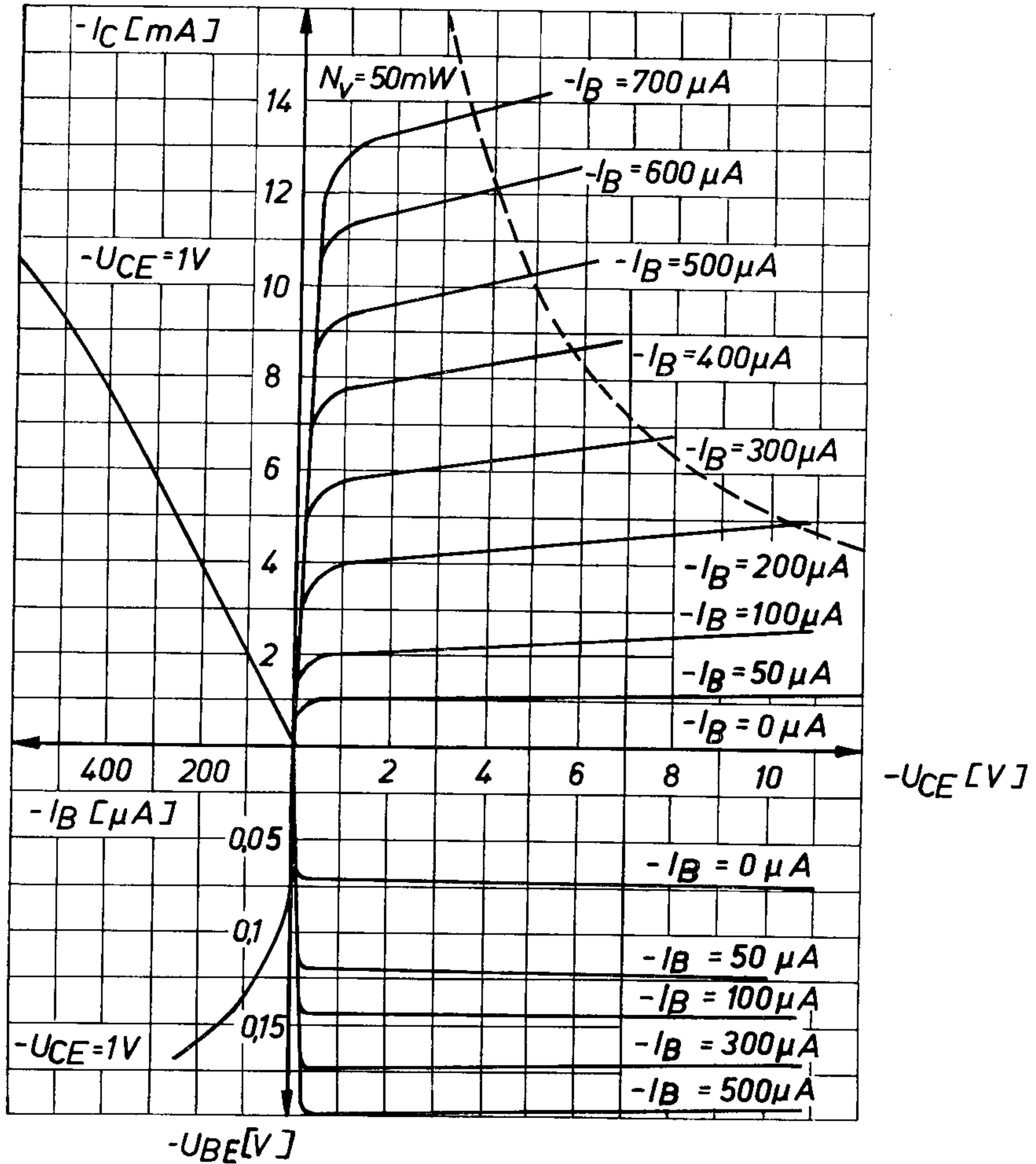


Änderungen vorbehalten

FLÄCHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 815
p-n-p-Flächentransistor
In Vorbereitung
Kennlinienfeld in Emitterschaltung



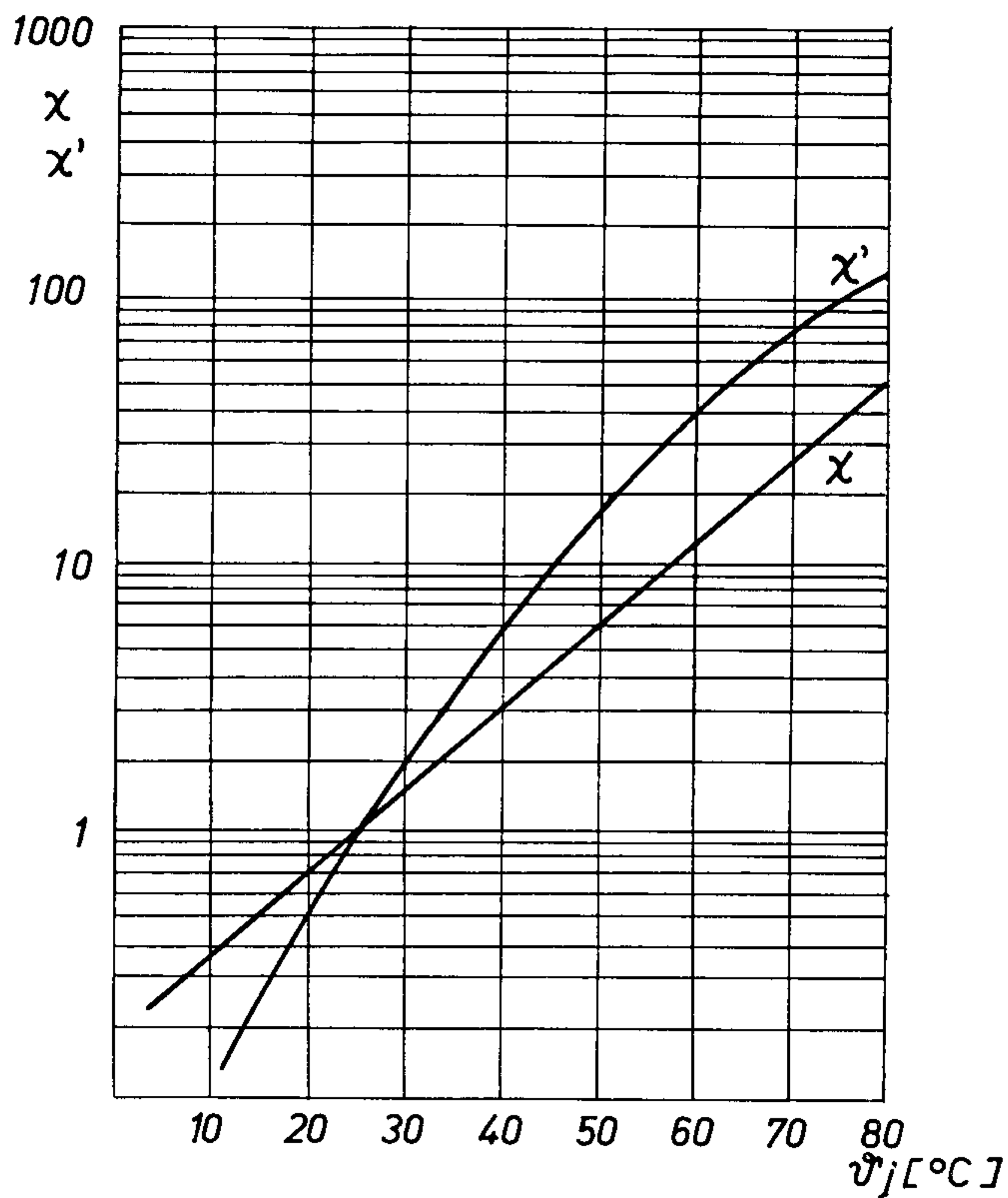
Änderungen vorbehalten

FLÄCHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 815; OC 816
p-n-p-Flächentransistoren
In Vorbereitung

Temperaturabhängigkeit des Kollektorreststromes



$$\chi = \frac{(J_{co})_{\vartheta_j}}{(J_{co})_{\vartheta_j = 25^\circ \text{C}}}$$

$$\chi' = \frac{(J'_{co})_{\vartheta_j}}{(J'_{co})_{\vartheta_j = 25^\circ \text{C}}}$$

Änderungen vorbehalten